#### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

[Claim(s)]

[Claim 1]One by one The anode, an electron hole injection zone, an organic emission band region (thickness which doubled a zone of these does not exceed 1 micrometer). And it is an electroluminescent device which consists of the negative poles and which has the electric power transformation efficiency of  $9x10^{-5}W/W$  at least, At least one side is a compound which can make at least 80% of radiant rays with wavelength of not less than 400 nm penetrate and in which said

electron hole injection zone has the following formula among these electrodes,

It is a basis on which  $Q^1$  and  $Q^2$  have a nitrogen atom and at least three rings (those things of aromatic series [ at least one piece ]) separately in here, An electroluminescent device which is a connecting group which G becomes from a cyclo alkylene group, an allylene group, an alkylene group, or carbon-carbon bonding.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許出願公告番号

特公平6-32307

(24) (44)公告日 平成6年(1994) 4月27日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 33/22

発明の数1(全 11 頁)

特願昭59-58088 (21)出願番号

(22)出願日

昭和59年(1984) 3 月26日

(65)公開番号

特開昭59-194393

(43)公開日

昭和59年(1984)11月5日

(31)優先権主張番号 478938

(32)優先日

1983年3月25日

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 999999999

イーストマン コダツク カンパニー アメリカ合衆国 ニューヨーク州 14650 ロチェスター市 ステート ストリート

343

(72) 発明者 スチープン・アーランド・バンスリク

アメリカ合衆国ニューヨーク州14613ロチ エスター市ピアーポント・ストリート324

(72)発明者 チャン・ウォン・タン

アメリカ合衆国ニューヨーク州14626ロチ エスター市バーモント・ドライブ197

(74)代理人 弁理士 湯浅 恭三 (外3名)

審查官 紀本 孝

(56)参考文献 特開 昭57-51781 (JP, A)

# (54)【発明の名称】 改良された電力転換効率をもつ有機エレクトロルミネツセント装置

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】順次陽極、正孔インジェクション帯域、有 機発光帯域(これらの帯域を合わせた厚さは 1 μ mを越 えない)、及び陰極からなる少なくとも9×10°W/ Wの電力転換効率をもつエレクトロルミネッセント装置 であって、

これらの電極のうち少なくとも一方は400 n m以上の 波長をもつ輻射線の少なくとも80%を透過させること ができ、且つ

前記正孔インジェクション帯域が次の式を有する化合物 10 であり、

ここにおいて、O'及びO'は別個に窒素原子及び少なく とも3個の炭素環(それらの少なくとも1個は芳香族の もの)を有する基であり、Gはシクロアルキレン基、ア リーレン基、アルキレン基又は炭素ー炭素結合からなる 連結基である、エレクトロルミネッセント装置。

#### 【発明の詳細な説明】

本発明は、有機化合物を発光手段とする、電気信号に応 答して発光するエレクトロルミネツセント装置に関す

有機エレクトロルミネツセント装置がそれらの対抗品と 十分に対抗しうるものとなるためには、対抗しうるコス トにおいてそれらの電力転換効率が増大することが望ま しい。電力転換効率は入力に対する出力の比(通常はW /W) と定義され、装置の駆動電圧の関数である。経済 的な駆動回路部晶を用いる駆動電圧、すなわち25ボル トを越えない電圧に関しては、電力転換効率は無機装置の場合  $1\times10^{\circ}$  W/W以下に限定されている。  $10^{\circ}$  W/W以上の電力転換効率をもつ、厚いフィルム(>5  $\mu$  m)または単結晶を用いる有機エレクトルミネツセント装置が開発されてはいる。しかしそれらの厚さが比較的大きいため、この種の装置を駆動させるのに要する電圧はかなり高い、すなわち 100 ボルトまたはそれ以上である。

駆動電圧を25ボルト以下に低下させるためには薄膜型 エレクトロルミネツセント装置が望ましい。これはここ 10 では有効な帯域または層の厚さ、すなわち電極間にある 物質の厚さが1 μ mを越えない装置を意味する。ピンホ ールの問題を考えると薄膜の形態を達成することは特に 困難であった。ピンホールは電池をショートさせるので 受入れられない。たとえばドレスナー、RCAレビュ 一、Vol、30、322ff頁(1969年6月)、特 に326頁を参照されたい。ピンホールの形成を防止す るために、被覆用配合物中に結合剤を使用することが好 都合とされている。この種の結合剤の例には付加重合体 たとえばポリスチレン、および縮合重合体たとえばポリ 20 エステルが含まれる。電池のショートは避けられるが、 結合剤を使用することは不満足な場合がある。このため には溶剤被覆加工法を用いる必要があり、ある層の溶剤 は下層の溶剤としても作用する可能性があり、これによ り層間の明瞭な境界設定が妨げられる。結合剤を必要と する1層を溶剤被覆したのち結合剤を必要としない層 (1層または多層)を蒸着させる方法は考えられるが、 逆の順序すなわち発光層を溶剤被覆する場合、溶剤が下 層に影響を与えた場合の実用性は照明されていない。 米国特許第4、356、429号明細書に記載された電 30 池は、正孔インジエクション帯域(hole injecting zon e) としてポルフィリン系化合物からなる層をもつ本発 明のものと同じ型の装置の一例である。

上記特許のセルは先行技術のセルよりも著しい改良を示したが、望まれている電力転換効率、すなわち25ボルトを越えない駆動電圧を用いた場合に少なくとも9×10°W/Wの水準を達成していない。正孔インジエクション層内のポルフイリン系化合物は有色であるため、セルにより放出される光を若干吸収するという望ましくない傾向を示す。またポリフイリン系化合物は有効に発光 40するために必要な正孔および電子の有効な発光的再結合を妨げると思われる。

本発明の目的は、少なくとも 1 桁改良された、すなわち 少なくとも  $9 \times 10^\circ$  W/Wに及び電力転換効率をもつ エレクトロルミネツセント(以下"EL")装置を提供することである。

本発明によれば、順次陽極、正孔インジェクション帯域、有効発光帯域(これらの帯域を合わせた厚さは  $1~\mu$  mを越えない)、および陰極からなり、

これらの電極のうち少なくとも 4 O O mu以上の波長をも 50 て特に有用なものは、前記の試験に関して少なくとも 5

つ輻射線の少なくとも80%を透過させることができ、かつ

少なくとも9×10°W/Wの電力返還効率をもつエレクトロルミネツセント装置が提供される。

本発明の装置において発光帯域または正孔インジェクション帯域はそれぞれ電子伝達化合物からまたは正孔伝達 化合物から作成され、これは本発明の実施態様の多くに おいてそれぞれの帯域に結合剤を用いずに行われる。

本発明のさらに他の有利な特色は、正孔インジエクション層用として、発せられた輻射線に対し実質的に透過性である化合物が見出されたことである。

本発明の他の有利な特色は添付の図面を考慮に入れて後 記の好ましい実施態様を参照することにより明らかにな るであろう。第1図は電源に接続した本発明装置の一部 の概略的断面図であり、

第2図は本発明に従って製造された装置に関する電力転換効率対エレクトロルミネツセン量子効率を示す対数ー対数グラフである。

正孔インジェクション物質および発光物質は各帯域内に存在する(この帯域が層であっても他のものであっても)。好ましいエレクトロルミネツセント装置においてこれらの物質は順次重なった被膜ないしは層中に存在する

正孔インジエクション層は正孔伝達化合物からなり、一 方発光層は電子伝達化合物からなる。

本発明者らは、後記のように駆動および構成されるセルに用いた場合に 5×10 光子/電子を越える E L 量子 効率を与える特定の電子伝達化合物があることを見出した。電力転換効率と E L 量子転換の間には直接的な関係があるので、これらの化合物を用いると前記の駆動電圧に関して電力転換効率は少なくとも 9×10 W/Wとなることが保証される。これらの化合物は容易に薄膜の形態で沈着するので、有効帯域を合わせた厚さが 1 μm を越えない薄膜型装置が容易に得られる。

本発明の装置に用いられる電子伝達化合物は、酸化還元 反応において還元されうる化合物である。本発明におい て特に有用なものは、前記の試験に関して少なくとも5 ×10 <sup>1</sup> E L 量子効率を与える電子伝達化合物である。 周知のように E L 量子効率は単純に外部回路で測定され る電子/秒に対する、セルから放出される光子/秒の比 に等しい。この効率を電力転換効率(W/Wの単位で定 義される)と混同してはならない。

電子伝達化合物が少なくとも $5\times10^{-1}$  光子/電子(すなわち0.05%)のEL量子効率を与えるか否かを判定するためには下記の試験を行う。

# E L セルは下記の順序で構成される:

400 nm以上の波長をもつ輻射線の少なくとも80%を 10 透過させる陽極 [たとえばネザトロン (Nesatron、商標) ガラス] ;本質的に1,1ービス (4ージーpートリルアミノフェニル) シクロヘキサンからなる正孔インジエクション層 : 問題の電子伝達化合物の層;およびインジウム製陰極。ここで正孔インジエクション層と発光層は合わせて厚さ1μを越えない。駆動電圧をかけ、最大電子転換効率または25ボルトのいずれかに達するまで (いずれが先に起こるとしても) 高める。この電圧において最大EL量子効率を測定する。

表 I には、上記のように構成され、かつ上記の電圧で駆 20 動される装置において試験した場合の若干の有用な電子 伝達化合物に関する E L 量子効率を示す。これらの例の それぞれにつき、最大 E L 量子効率の電圧は 2 5 ボルト の制限以下であった。

表	<u>I</u> _		
構造	最大DL量子 効率*	測定点におけ る駆動電力	
ネザトロン陽極/エピンド リジオン'(1500 Å)/イン ジウム(ln)陰極	2×10 <sup>-4</sup>	18V	

測定点におけ 最大LL量子 構造 効率\* る駆動電力 (比較例) ネザトロン陽極/HI-1<sup>2</sup>(75nm)/El<sup>3</sup>(75nm)/In  $1 \times 10^{-2}$ 207 ネザトロン陽極/HI-1(75 8×10<sup>-3</sup> 207 nm)/E2\*(75nm)/In陰極 157 ネザトロン陽極/HI-1(75  $3 \times 10^{-3}$ nm)/E35(75nm)/In陰極 12,5V  $3 \times 10^{-3}$ ネザトロン陽極/HI-1(75 nm)/E46(75nm)/In陰極 ネザトロン陽極/HI-1(75  $1.5 \times 10^{-3}$ 24Y nm)/E57(75nm)/In陰極 ネザトロン陽極/HI-1(75  $5 \times 10^{-3}$ 157 nm)/E68(75nm)/in陰極  $8 \times 10^{-3}$ 147 ネザトロン陽極/HI-1(75 nm)/E7\*(75nm)/ln陰極

6

E5を除いて有効数子1個に四捨五入した。

1エピドリジン=

\*30

$$\begin{array}{c} C_2H_5 \\ (CH_3)_2C \\ \\ (CH_3)_2C \\ \\ (CH_3)_2C \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} C_2H_5 \\ \\ \\ C(CH_3)_2 \\ \\ \end{array}$$

[4, 4'-ビス[5, 7-ジーtーペンチルー2ーベ 40% 4 E 2 = ンゾキサゾリル] スチルペン〕 ※

 $[2, 5-\forall x \{5, 7-\vec{y}-t-\vec{q}y \neq v -2-\vec{q}y \ *5E3 =$ ゾキサゾリル]チオフェン]

(2, 2' - (1, 4-フェレンジビニレン) ビスベン ゾチアゾール〕

[2, 2'-(4, 4'-ビフェニレン) ビスベンゾチ ★7E5=ビス(8-ヒドロキシキノリノ) マグネシウム アゾール〕

 $[2.5-\mathrm{i} 2.5-\mathrm{i} 2.5]$ 2-ベンゾキサゾリル〕チオフェン〕

「2. 5ービス「5. 7ージーtーペンチルー2ーベン ゾキサゾリル] -3, 4-ジフェニルチオフエン] ここで用いられる正孔インジエクション層の正孔伝達化 合物は、電場を与えられた2個の電極間に配置されて陽 極から正孔がインジエクトされた場合、正孔を適切に陰 伝達化合物は、 $10^{4} \sim 10^{6}$  ボルト/cmの電場を与えら れた電極間に層が配置された場合少なくとも 10° cm<sup>2</sup> /ボルトー秒の正孔移動係数をもつ。最も好ましい正孔 伝達化合物は容易にかつ可逆的に酸化されうる芳香族ア ミンであることが見出された。

より好ましくは、正孔インジエクション層は本質的に無 色である。これは陽極に隣接した位置にあり、陽極は透 明な電極であることが好ましい。従って正孔伝達化合物 も400mn以上の波長において少なくとも90%透過 性であることが好ましい。

本発明に用いられる正孔伝達化合物のあるもの、および 電子伝達化合物のあるものは、薄膜形成性化合物である という付加的な性質をもつことが注目される。ここで用 いられるようにある化合物がこの物質を電極などの支持 体上に 0. 5 μ m以下の厚さで施した場合に"薄膜形成 極へ伝達することができる化合物である。好ましい正孔 40 性"である場合、これは実質的にピンホールを含まない 層を形成する。しかしある化合物が薄膜形成性であると いうことは必ずしも0、5μmよりも多量に存在しない ということを意味するわけではない。有効帯域の一方の 層がこの種の薄膜形成性化合物である場合、両層におい て結合剤を除くことができるという点でこの薄膜形成性 は有用である。従って本発明の一実施態様においては、 発光層および正孔インジェクション帯域の双方が結合剤 を含有しない。

あるいは他の場合には正孔と電子の発光的再結合を妨げ 50 ない結合剤も本発明に有用である。

前記のように薄膜を形成しうる化合物の有用な例を以下 に示す。特に有用な例には複素環もしくは炭素環、および3個以上の炭素原子を有する脂肪族鎖少なくとも2個 を含有するか、あるいは少なくとも2個の基すなわちそれぞれa)一重結合の餌りに回転しうる基およびb)少なくとも3個の芳香族もしくは飽和炭素環を含む基を含有する化合物が含まれる。

たとえば薄膜形成性である正孔伝達化合物には次式の構造をもつものが含まれる。

a)

\*上記式中Q<sup>†</sup>およびQ<sup>2</sup> は別個に窒素原子および少なくとも3個の炭素環(それらのうち少なくとも1個は芳香族のもの、たとえばフェニル基である)を含有する基である。炭素環は飽和された環、たとえばシクロヘキシル基およびシクロヘプチル基であってもよく;Gは連結基、たとえばシクロアルキレン基、たとえばシクロヘキシレン基;アリーレン基たとえばフェニレン基;アルキレン基たとえばメチレン基、エチレン基およびプロピレン基;あるいはCーC結合である。構造a)の範囲内の10 個々の例には、特に下記のものが含まれる。次式の構造をもつ1,1ービス(4ージーpートリルアミノフェニル)-4ーフェニルーシクロヘキサン;i)

10

\*

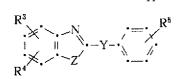
1, 1-ビス(4-ジーpートリルアミノフェニル)シ ※ii) クロヘキサン;および次式の構造をもつ化合物 ※30

(上記式中nは2~4の整数である)、たとえば4,4 ''' ービス(ジフェニルアミノ)クワドリフェニル。 さらに他の有用な正孔伝達化合物には米国特許第4,1 75,960号明細書13欄13行から14欄42行に列挙されたもの、たとえばビス(4ージメチルアミノー2ーメチルフェニル)フェニルメタンおよびN,N,Nートリ(p-トリル)アミンが含まれる。

薄膜形成性の電子伝達化合物に関しては、好ましい例に は螢光増白剤が含まれる。最も好ましいものは次式の構 造をもつ螢光増白剤である。

または

c)



これらの式中R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> およびR<sup>4</sup> は別個に水素原子: 1~10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残基、たとえばプロピル基、tーブチル基およびへプチル基; 6~10個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフェ 10 二ル基およびナフチル基; あるいはハロゲン原子、たとえば塩素原子およびフツ素原子であるか; あるいはR<sup>2</sup>とR<sup>2</sup>、またはR<sup>3</sup>とR<sup>4</sup>が一緒になって、1~10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残基(たとえばメチル基、エチル基およびプロピル基)少なくとも1個を含んでいてもよい縮合芳香族環を完成するために必要な原子を構成し、

 $R^3$ は1~20個の炭素原子を有する飽和脂肪族残基、たとえばメチル基、エチル基およびnーアイコシル基; 6~10個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフ 20ェニル基およびナフチル基;カルボキシル基:水素原子;シアノ基;あるいはハロゲン原子、たとえば塩素原子およびフツ素原子であり;ただし式c)において $R^3$ ,  $R^1$ および $R^3$ のうち少なくとも2個は3~10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残基、たとえばプロピル基、ブチル基またはヘプチル基であり、

Zは-O-、-NH-または-S-であり; Yは

 $-R^6+CH=CH-\frac{1}{6}-R^6-$ 

-CH = CH -.

 $+CH=CH\rightarrow_{\overline{n}}R^{6}+CH=CH\rightarrow_{\overline{n}}$ ,

または

であり、

mは0~4の整数であり;

nは0、1、2または3であり;

 $R^{5}$  は  $6\sim10$  個の炭素原子を有するアリーレン基、たとえばフェニレン基およびナフチレン基であり;  $R^{7}$  は水素原子または  $6\sim10$  個の炭素原子を有するアリール基であり;そして

12

Z'および Z"は別個にNまたは C Hである。 上記の脂肪族残基は置換されていてもよい。置換された 脂肪族残基の場合の置換基には、1~5個の炭素原子を 有するアルキル基、たとえばメチル基、エチル基および プロピル基;6~10個の炭素原子を有するアリール 基、たとえばフェニル基およびナフチル基;ハロゲン原 子、たとえば塩素原子およびフツ素原子;ニトロ基;な らびに1~5個の炭素原子を有するアルコキシ基、たと えばメトキシ基、エトキシ基およびプロポキシ基が含ま

特に好ましい螢光増白剤の例には下記のものが含まれ る。2.  $5 - \forall Z$ (5、 $7 - \forall - t - \forall \gamma \neq \nu - 2 - \forall \tau$ ンゾキサゾリル) -1, 3, 4-チアジアゾール; 4, 4' -ビス(5, 7-t-ペンチル-2-ベンゾキサゾ リル)スチルベン;2、5ービス(5、7ージー1ーペ ンチルー2ーベンゾキサゾリル)チオフェン:2,2' - (p-フェニレンジビニレン) - ビスベンゾチアゾー 30 ル; 4, 4′ービス(2ーベンゾキサゾリル)ビフェニ -2-ベンゾキサゾリル]チオフェン;4.4′ービス [5, 7-ジー(2-メチルー2-ブチル)ー2ーベン ゾキサゾリル〕スチルベン;および2.5~ビス〔5. 7-ジー2-メチルー2-ブチル)-2-ベンゾキサゾ リル] -3、4-ジフェニルチオフェン。 さらに他の有用な螢光増白剤はケミストリー・オブ・シ ンセティック・ダイズ、1971、628~637頁お よび640頁に列挙されている。すでに薄膜形成性では 40 ないものは、一端または両端の環に脂肪族の基を結合さ せることによって薄膜形成性にすることができる。この 種のさらに有用な螢光増白剤には、たとえば下記のもの が含まれる。

ル] ビニル} ベンゾイミダゾール]

「5ーメチルー2ー{2ー〔4ー(5ーメチルー2ーベ ンゾキサゾリル)フェニル] ビニル ベンゾキサゾー \*

「2、5-ビス(5-メチル-2-ベンゾキサゾリル) チオフェン

**「2−〔2−(4−カルボキシフェニル)ビニル〕ベン** ゾイミダゾール)

および

[2- [2- (4-クロルフェニル) ビニル] ナフト [1, 2-d] オキサゾール]

さらに他の有用な薄膜形成性の電子伝達化合物には8-ヒドロキシキノリンの金属錯体が含まれ、その際金属は 好ましくはZn、Al、MgまたはLiである。

有効層の一方が薄膜形成性である場合、容易に認められ るようにピンホールのため装置がショートすることはな いので、他方は薄膜形成性である必要はない。たとえば 有用な装置は、前記の薄膜形成性化合物からなる正孔イ 40 くとも9×10°W/Wである。ある場合にはこの効率 ンジエクション層、および薄膜形成性でない化合物、た とえば1, 1, 4, 4ーテトラフェニルー1, 3ーブタ ジエンからなる発光層を含む。

前記の表』から明らかなように、有用な陽極電極には商 標"ネザトロン"のもとにPPGインダストリーズ社か ら得られる被覆ガラス陽極が含まれ、有用な陽極電極に はインジウムが含まれる。一般のいかなる陽極および陰 極もそれが適切な仕事関数値をもつならば使用できる。 たとえば陽極は高い仕事関数をもつべきである。他の有 用な陽極の例にはいずれかの半透明な高い仕事関数をも 50 ある場合、発光層を形成するためには蒸発が好ましい。

つ導電性材料、たとえば酸化スズインジウム、酸化ス ズ、ニッケルまたは金で被覆したガラスが含まれる。好 ましくは、この種の陽極は10~1000オーム/スク エアー (ohms/square) のシート抵抗、および400nm 以上の波長に対し80%の光透過率をもつ。このように 高い光透過率を少なくとも90%という正孔伝達化合物 20 の透過率と合わせた場合に、本発明に従って作成された 装置の特色である卓越した電力転換効率が保証される。 他の有用な陰極の例には低い仕事関数をもつ他の金属、 たとえば銀、スズ、鉛、マグネシウム、マンガンおよび アルミニウムが含まれる。金属が装置により発生するル ミネツセンスに対して高い透過率をもつか否かは関係な

第1図は本発明に従って製造されたエレクトロルミネツ セント装置を示す。これは酸化スズインジウムの半透明 被膜16で被覆されたガラス製支持体14からなる陽極 30 12を含む。この上に正孔インジエクション層18が配 置される。発光層20は層18上に配置される。層18 および20の一方または双方が薄膜形成性化合物であ る。陰極22は層20上に配置され、リードワイヤ24 が装置を電源26に接続する。電源26を入れると陽極 12で発生した正孔は層18と20の界面へ伝達され、 ここで陰極22から伝達された電子と結合し、可視光線 hνを発する。

電源26が装置10の最大出力点の電圧たとえば15~ 25ボルトで操作される場合、最大電力転換効率は少な が2×10°に及ぶことが認められた。本発明の装置は 改良された電力転換効率の結果1700cd/m²(500 フィートランベルト) に及ぶ最大輝度を生じることが認 められた。

本発明のEL装置は常法により作成される。すなわち正 孔インジエクション層、発光層および陰極をそれぞれ溶 液被覆法または蒸発により施す。正孔インジエクション 層が最初に形成されることが好ましい。発光層に有用な 溶剤が正孔インジエクション層に対しても良好な溶剤で

ここで用いられる"蒸発"には蒸気相からの沈着のあら ゆる形態が含まれ、真空下で行われるものも含まれる。 下記の実施例により本発明をさらに説明する。これらの 実施例において最大輝度は不可逆的破壊を生じる電圧の すぐ下の電圧で測定される。若干の実施例において駆動 電圧について25Vという好ましい限度を越える輝度に 関する電圧が示されているのはこのためである。

#### 実施例1

第1図のものと類似したエレクトロルミネツセント装置 (以下"セル")を以下により製造した。

1) 陽極を作成するため、ネザトロンガラスをまず0. O 5 μmアルミナの研摩材で数分間研摩した、次いでイ ソプロピルアルコールおよび蒸留水の1:1(V)混合物 中で超音波清浄した。次いでこれをイソプロピルアルコ ールですすぎ、窒素で送風乾燥させた。最後に、使用前 にこれをトルエン中で超音波洗浄し、窒素で送風乾燥さ せた。

2) 1. 1ービス(4ージーpートリルアミノフェニ ル) シクロヘキサン (HI-1) をネザトロンガラス土 に一般的な真空蒸着法により沈着させた。すなわち上記 20 物質を雷気的に加熱されたタンタル製ボートから320 ℃の温度で5×10°トルの系内圧力において蒸発させ た。ネザトロンガラスに沈着した生成HI-1フィルム\*

\*の厚さは75mmであった。

3) 次いで4. 4'-ビス(5. 7-ジーtーペンチル -2-ベンゾキサゾリル)スチルベン(E1)を2)に 記載したと同じ手法を用いて、ただし供給源温度350 ℃を採用してHI-1層の上部に沈着させた。E1層の 厚さも75mであった。

4) 次いでインジウムを E 1 フィルムの上部にシャドー マスクを介して沈着させた。 In電極の面積は 0.1cm 「であり、これもエレクトロルミネツセントセルの有効」

### 10 面積を規定した。

出来上がったセルはセザトロンガラス電極をプラスとし てバイアスをかけた場合、青緑色の光を放出した。放出 された光は520nmに最大放出を有していた。達成され た最大輝度は与えられた電圧が22Vである場合、電流 密度140mA/cm<sup>\*</sup>において340cd/m<sup>\*</sup>であった。2 0 V で駆動した場合、最大電力転換効率は1. 4×10 W/Wであり、最大エレクトロルミネツセント量子効 率は1.2×10 光子/電子であった。

#### 実施例2

#### 発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを 製造した。ただし下記の螢光増白剤を発光層として用い

$$\begin{array}{c|c} C_2H_5 & C_2H_5 \\ (CH_3)_2C & & C(CH_3)_2 \\ \hline \\ C_2H_5 - C(CH_3)_2 & C_2H_5 - C(CH_3)_2 \\ \hline \end{array}$$

(2, 5-ビス(5, 7-ジーtーペンチルー2-ベン yキサゾリル) -1, 3, 4-チアジアゾール] 実施例1と同様にしてセルを製造した。ただし螢光増白 剤の蒸発のための供給源温度は260℃であった。放出さ れた光は橙色であり、590nmに最大放出を有していた。 得られた最大輝度は30Vおよび40mA/cm<sup>2</sup>において 3 4 0 cd/n であった。2 0 V で駆動された場合、最大 電力転換効率は1.5×10°W/Wであり、最大EL※ ※量子効率は1.4×10<sup>2</sup> 光子/電子であった。 実施例3

発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを 製造した。ただし2、2′-(p-フェニレンジビニレ ン) ビスベンゾチアゾール(E3)を発光層として用い、 300℃で蒸発させた。

このセル(ネザトロン/HI-1/E3/In) は緑色の光を放出し、これは560mに最大放出を有し ていた。得られた最大輝度は17.5Vおよび200mA/c  $m^2$ において340cd/ $m^2$ であった。15Vで駆動した場 合、最大電力転換効率は4×10<sup>-4</sup> W/Wであり、最大 エレクトロルミネツセント量子効率は $3 \times 10^{-1}$  光子/ 50 ェニルベンゾキサゾール (PBBO) を発光層としてE

量子であった。

実施例4

発光層用の他の物質

前記実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセ ルを製造した。ただし2-(4-ビフェニル)-6-フ

18

1の代わりに用い、200℃で蒸発させた。

このセル(ネザトロン/HI-1/PBBO/In)は (5,7-ジーtーベンチルー2ーベンゾキサゾリル) 白青色の光を放出した。得られた最大輝度は25 V およ 10 −3,4-ジフェニルチオフェン(実施例 6)からなび50mA/cm² において34cd/m² であった。20 V で駆動 り、340  $^{\circ}$  の温度で蒸発させた。表日に結果を示す。した場合、最大電力転換効率は9.5×10 $^{\circ}$  W/Wで\*

\*あり、最大エレクトロルミネツセント量子効率は8×1 0<sup>-1</sup> 光子/電子であった。

実施5および6

発光層用の他の物質

I

実施例	色	最大放出	最大輝度	最大電力転換効率	最大EL量子効率	効率測定駆動電力	
5	緑	530nm	680cd/㎡ (19Vおよび150mA/㎡において)	7×10 <sup>-</sup> ⁴₩/₩	5×10-3量子/電子	157	
6	#	n	1700cd/㎡ (20Vおよび300mA/cポにおいて)	1.4×10 <sup>-8</sup> W/W	8.4×10 <sup>-3</sup> 量子/電子	147	

## 実施例7

薄膜形成性でない電子伝達化合物

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを※

※製造した。ただし、1, 1, 4, 4ーテトラフェニルー20 1, 3ーブタジエン(TPB)を発光層として用いた。

TPB昇華のための供給源温度は210℃であった。このセルは青色の光を放出し、これは450nmに最大放出を有していた。得られた輝度は20Vおよび200mA/cm<sup>2</sup>において102cd/m<sup>2</sup>であった。15Vで駆動した場合、最大電力転換効率は2×10<sup>-4</sup> W/Wであり、最大エレクトロルミネツセント量子効率は1.2×10<sup>-3</sup> 光子/量子であった。このセルは蒸発したTPB層の不均質なかつ薄膜形成性でない性質にもかかわらず機能した。TPB層は顕微鏡下で見た場合小さなクラスターのモザイクの外観を有していた。

#### 実施例8および9

電子伝達化合物として8-ヒドロキシノリノの金属錯体 を使用

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを 製造した。ただしビス(8-ヒドロキシキノリノ)アル ミニウム(実施例8)、および次式

の構造をもつビス(8ーヒドロキシキノリノ)マグネシウムをそれぞれ発光層として用いた。操作条件は実施例1の記載と同様であった。ただし金属錯体の供給源温度はそれぞれ330 $^{\circ}$ C(実施例8)および410 $^{\circ}$ C(実施例9)であった。表 $^{\circ}$ Lに結果を示す。

上記各実施例に示した効率を便宜のため第2図にプロツトした。第2図の点線は傾向を示すにすぎず、いずれかの方法による最適なものを表わすものではない。そこに示されたデータは関係式

log(電力転換効率)=log(EL量子効率)+logK

(上記式中 K は切片(intercept)であり、駆動電圧によって一部制御される係数である)に従うとほぼ直線状である。駆動電圧(第1図の電源26)の値が上がるのに伴って、第2図の曲線は下方へ移動する。従ってより高い駆動電圧では、同一のE L 電子効率でも、もはや希望する $9\times10^{\circ}$  W/Wの電力転換効率を与えないようになるであろう。

# 【図面の簡単な説明】

\* 第1図は電源に接続した本発明装置の一部の概略的断面 図であり、

第2図は本発明装置に関する電力転換効率対エレクトロ 10 ルミネツセント量子効率を示す対数一対数グラフであ る。

図中の各記号は下記のものを表わす。

10:エレクトロルミネツセント装置;

12:陽極;14:ガラス製支持体;

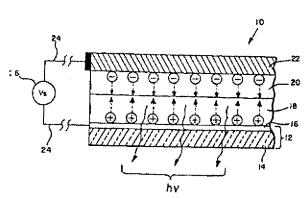
16:半透明被膜;

18:正孔インジエクション層;20:発光層;

22:陰極;24:リードワイヤ;

26:電源。

【第1図】



【第2图】

